PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-009860

(43)Date of publication of application: 14.01.2003

(51)Int.Cl.

C12N 15/09 C12M 3/00 C12N 5/06 GO1N 33/53 GO1N 37/00

(21)Application number: 2001-195425 (22)Date of filing:

27.06.2001

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72)Inventor: KAWAMURA KOICHI YAMAZAKI SUMIAKI

(54) COMPARTMENTED CULTURE SUBSTRATE AND DNA CHIP USING THE SAME (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a widely applicable compartmented culture substrate capable of easily forming in high sensitivity and resolution on light exposure or heating highly hydrophilic area suitable as cell-nonadhesive area and also capable of pattern formation based on digital data by operating an infrared laser or the like, and to provide an excellent DNA chip capable of easily forming fine patterns.

SOLUTION: This culture substrate has the following structure: the surface of a substrate is provided with a graft layer of a high-molecular compound having functional group whose hydrophilicity/hydrophobicity change by the action of heat, acid or radiation and having a structure directly bindable via chemical bond to the substrate. This culture substrate is characterized in being obtained by irradiating a specified area of the graft layer with radiation or feeding the area with heat or acid to change the hydrophilicity/hydrophobicity of the graft layer surface to compartment the graft layer surface into cell- adhesive area and cell-nonadhesive area.

(19)日本国特許庁(JP) (12)公開特計	(43)公開E	(11)特許出職公開番号 特別2003 — 9860 (P2003 — 9860A) i 平成15年 1 月14日 (2003, 1, 14
(51)Int.CL ⁷	識別記号	P I	テーマュード(参考)
C 1 2 N 15/09		C12M 3/00	4 B 0 2 4
C 1 2 M 3/00		GOIN 33/53	M 4B029
C12N 5/06		37/00	102 4B065
G 0 1 N 33/53		C 1 2 N 15/00	F
37/00	102	5/00	E
		密查請求 未請達審	請求項の数4 OL (全 14 頁
(21)出線番号 特線2001-195425(P2001-195425) (71)出級人 000005201 育十写真		フィルム株式会社	
(22)出版日	平成13年6月27日(2001.6.27)		商足橋市中绍210番地
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(72)発明者 川村 浩	
		静岡県株)	聚都吉田町川県1000番地 當士等 A株式会社内
		(72) 発明者 山崎 総5	夠
			聚都吉田町川県4000番地 富士等
			ム株式会社内
		(74)代謝人 100079049	
		弁理士 1	中島 淳 (外3名)

(54) 【発明の名称】 区域培養基板及びそれを用いたDNAチップ

(57)【要約】

(評価) 森光、加熱により意感度 高級保険で、組設の非要維制能に対象と構造を指す。 の事業を維制能に対象と高性性の観点なる第4元形成でき、しかも、赤外側レーザ等を操作することによりデジタルデータに蓄つれたパターン形成中間放化、促用報程の成しる各種化たのドルチンで整備する。 成しろも優れたのドルチンで整備する。 成地方を優れた。 成地方を優れた。 成地方を開心が変化する音楽部を有り、目つ、放支的体上に 直接化学場合とは、均結合される。 場立を有する。 が成れ、 がの場合とは、 がの場合とは、 がの場合とない、 がの場合とない、 がの場合とない。 がのる。 をのる。 をのる。 をのる。 をのる。 をのる。 をのる。 をのる

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に、熱、酸または輻射線により 親疎水蛭が変化する官能基を有し、且つ、該支持体上に 直接化学結合により結合されるる構造を有する高分子化 台物かちなるグラフト層を構え、該グラフト層の所定額 域に、加熱、酸の供給または輻射線の輻射を行って、グ ラフト層表面の頻線水性を変化させ、グラフト層表面を 細胞接着性領域と細胞非接着性領域に区面してなること を特徴とする区面培養基板。

【請求項2】 前記熱、酸または輻射線により頻疎水性 10 照射することによって細胞接着性の官能基を導入した が変化する官能基を有し、且つ、該支持体上に直接化学 結合により結合されらる構造を有する高分子化合物が、 高分子鎖の末端で直接化学結合により数支持体表面に結 合されている直鎖状高分子化合物であるか、もしくは、 高分子鎖の末端で軽高分子化合物を介して化学的結合に より該支持体表面に結合されている直鎖状高分子化合物 であることを特徴とする職求項1に記載の区画培養基

【請求項3】 胸記加熱 酸の供給または輻射線の解射 を行った後のグラフト屋表面における疎水性領域が、細 20 する細胞培養用基板が開示されている。 **応接着性鎖域であることを特徴とする請求項1に記載の** 区固培養基板。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3に記載の区価総養 基板にDNAを固定化してなるDNAチップ。 【発明の詳細な説明】

[9001]

【祭明の属する技術分野】本発明は区間接着基板に開 し、特に、細胞やDNAを吸着させる領域の大きさや形 状を容易に同定しうる区面培養基板及びそれを用いて得 ちれるDNAチップに関する。 [0002]

【従来の技術】現在、種々の目的で細胞培養或いは細菌 培養が行われており、また、新たな細胞の培養法も開発 されている。特に細胞培養は、生化学的現象や性質の解 明 有用な物質の生産などの目的で広範に利用されてお り、さらに、培養細胞を用いて、人工的に合成された薬 剤の生理活性や毒性を調べる試みがなされている。多く の動物細胞は、何かに接着して生育する接着依存性を有 しており、このような接着依存性を有した細胞の培養に ては、一般的には、コラーゲンやフィブロネクチンなど の細胞接着性タンパク質が用いられ、これらを均一に途 布したプラスティック製の培養皿が用いられている。 【0003】一方、目的に応じて、培養細胞を基板上の 微小な部分にのみ接着させ、配列させる技術が報告され ている。このような技術により、培養細胞を人工臓器や バイオセンサーバイオリアクターなどに応用することが 可能になる。培養細胞を配列させる方法としては、細胞 に対して接着の容易さが異なるようなグラフト層がパタ ーンをなしているような区画培養基板を用い、細胞が接 50 【発明が解決しようとする課題】上記従来の技術の欠点

着しやすい領域を形成し、その表面だけに細胞を接着さ せることで、区面培養を可能とし、所望の細胞の配列バ ターンを形成させる方法がとられ、種々のパターン形成 法が提案されている。

【0004】例えば、特開平2-245181号公報に は、回路状に神経細胞を増殖させるなどの目的で、静電 荷パターンを形成させた電荷保持線体を細胞培養に応用 している。また、新聞平3-7577号公錫では、網防 非接着性表面を有した細胞培養材料に熱外線や放射線を

り、細胞培養特別に紫外線や放射線を昭射することによ って重合開始種を誘導し、この上に緩縮接着性あるいは 細胞非接着性をノマーを重合させるなどして表面をバタ ーニングし、これによって細胞の配列を制御する方法が 提察されている。さちに、特勝平3-7576号公叙で は、細胞非接着性あるいは細胞接着性の光感受性親水性 高分子を、特開平5-176753号公報では、細胞の 接着率や形態に影響を与えるコラーゲンなどの物質を、 いずれもフォトリングラフィー法によってパターニング

【9905】このように任意の区面バターンを有する培 養蕃板は、種々の分野に応用が可能であり、前述の生化 学的現象の解析、有用な物質の生産などの他、細胞を用 いた超小型バイオセンサー、スイッチング素子、バイオ リアクター、ハイブリッド型入工機器。さらにはニュー ロコンピューターへの応用も可能であり、さらに、近年 注目されているDNAチップにも適用することができ

【0006】従来の一般的なパターン形成方法。例え 30 ば、コラーゲンやフィブロネクチンなどの細胞接着性タ ンバク質を吸着させて細胞接着領域を形成する場合、第 1に所望のミクロパターンを形成するのが困難で、タン パク質の接着領域と非接着領域の界面がクリアに分回し 離く、第2に細胞接着性タンパク質が、培養細胞に作用 して、細胞の形態に影響を与える可能性があり、用途が 限定されるといった問題を有している。また、このよう な細胞接着性タンパク質を用いず、基材にフォトリソグ ラフィー法によるパターンニングで細胞の接着領域、非 接着領域を作成する場合には、細胞非接着性の領域では は、機能が接着するための担体が必要である。担体とも 46 安定性と効果の観点から、高い観水性とその特貌性が求 められているが、従来の額水性高分子では、前記二つの 特性を満足しうるものは限られている。特に区面培養基 板をDNAチップに用いる場合、500μm以下 好ま しくは10~200μm程度の解像度が要求され、この ような高解像度のパターン形成が可能で、且つ、高く待 続性に優れた親水経鎖域を形成することが、精度の高い 区面培養には必須の技術であるが 実用上満足するレベ ルのものは未だ得られていないのが顕状である。 [0007]

特剛2003-9860

を考慮してなされた本発明の目的は、電光或いは加熱に より高感度、高解像度で、細胞の非吸着領域に好適な高 親水性の鎖域が容易に形成でき、しかも、赤外線レーザ 等を操作することによりデジタルデータに基づいたパタ ーン形成が可能な、応用範囲の広い区画培養基板 及 び、微細なパターンを容易に形成しろる優れたDNAチ ップを提供することにある。 180001

【課題を解決するための手段】 本発明者等は、鋭意検討 した結果、露光、加熱、赤外線レーザの順射により表面 10 の特性が変化する高分子化合物を応用することで上記目 的が達成されることを見いだし本発明を完成するに至っ た。すなわち、本発明の区園培養基板は、支持体上に、 熱、酸または輻射線により親線水性が変化する官能基を 育し 日つ、該支持体上に直接化学結合により結合され うる構造を有する高分子化合物からなるグラフト層を備 え. 該グラフト層の所定領域に、加熱 酸の供給または 輻射線の照射を行って、グラフト層表面の報導水性を変 化させ、グラフト階表面を細胞接着性領域と細胞非接着 性領域に区画してなることを特徴とする。

【0009】ととで、前記熱、酸または輻射線により観 疎水性が変化する官能基を育し、且つ、該支持体上に直 提化学結合により結合されるる構造を有する高分子化合 物が、高分子鎖の末端で直接化学結合により該支持体表 面に結合されている直鎖状高分子化合物であるか、もし くは、高分子鎖の末端で幹高分子化合物を介して化学的 結合により該支持体表面に結合されている直鎖状態分子 化合物であることが好ましい。本発明においては、加 熱、酸の供給または輻射線の解射を行った後のグラフト 能することになる。また、本発明の請求項4に係るDN Aチップは、前記の区画培養基板にDNAを固定化して なることを特徴とする。

【0010】本発明の区園培養基板は、その表面に、 ぬ 酸または輻射線により頻醇水性が変化する官能基 (以下、適直、極性変換量と称する)を有する高分子化 台物の表面の極性に応じて、露光を含む輻射線照射領 域、加熱領域に選択的に積水性或いは疎水性の区面が形 成されるため、草板の面積に係わらず、デジタルデータ 養華板のグラフト圏に用いられる極性密線基を育する高 分子化合物は 例えば、その末端で直接または幹高分子 化合物を介して支持体に結合しており、形成される親水 **性循域は高い強度と耐磨耗性を示すことになる。さら** に、本発明においては、親水性/顔水性を決定する極性 変換基は、運動性の高いグラフト銀構造を有するため、 公知の一般的な架装高分子時による親水管領域における 水分子との親和性に比較して、水分の吸着速度が極めて 早く、単位面積当たりに保持しろる水分量が多くなり、 高い親水性を発現し、先に述べたその耐久性と合わせ 50 【0015】〔穀鶏水性が変化する官館基〕次に、本発

て、細胞非吸着領域としての機能に優れ、高無條序の細 腔の接着パターンを作成しろるという特徴を有する。 [0011]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の区面培養基材に ついて詳細に説明する。本発明の区面培養基材の特徴で ある。親韓水性が変化する官能基を有する高分子鎖の末 鑑が直接もしくは幹高分子を介して支持体表面に化学的 に結合された寿面を作成するための手段について説明す

【表面グラフト筆台】玄楽明に係る区面接着基板は --般的に表面グラフト重合と呼ばれる手段をもちいて作成 される。グラフト重合とは高分子化合物鎖上に活性種を 与え、これによって重合を開始する別の単置体をさらに 重合させ、グラフト(接ぎ木)重合体を合成する方法 で、特に活性種を与える高分子化合物が固体表面を形成 する時には表面グラフト重合と呼ばれる。

【0012】本発明を実現するための表面グラフト重合 法としては文献記載の公知の方法をいずれも使用するこ とができる。たとえば、新高分子実験学10、高分子学 20 会編 1994年、共立出版(株)発行、P135には 表面グラフト重合法として光グラフト重合法、プラズマ 照射グラフト革合法、が記載されている。また 吸着校 術便職、NTS(株)、竹内監修、1999.2発行、 p203、p695には、y線、電子線などの放射線筋 射グラフト重合法が記載されている。光グラフト重合法 の具体的方法としては特開平10-296895号公銀 および特闘平11-119413号公報に記載の方法を 使用することができる。

【0013】高分子化合物鎖の末端が直接に化学的に結 歴表面における疎水性領域が、細胞接着性領域として観 30 台された表面グラフト層を作成するための手段としては これらの他、高分子化合物鎖の末端にトリアルコキシシ リル華、イソシアネート華、アミノ華、水酸基、カルボ キシル基などの反応性官能器を付与し、これと支持体表 面に存在する官能基とのカップリング反応により形成す ることもできる。なお、本発明における支持体表面と は、その表面に、操性変換差を有する高分子化合物の末 蟾が直接または幹高分子化合物を介して化学的に結合す る機能を有する表面を示すものであり、 支持体白体がと のような表面特性を有するものであってもよく、また該 に基づく高層像度のバターン形成が可能となる。区画語 40 支持体上に卵溢中間層を設け、該中間層がこのような特 性を有するものであってもよい。

> 【0014】また、福姓変換基を有する高分子化合物額 の末端が幹高分子化台物を介して化学的に結合された表 面を作成するための手段としては、支持体表面官能基と カップリング反応しうる官能基を幹高分子高分子の側鎖 に付与し、グラフト鎖として銀線水性が変化する官総基 を有する高分子化台物鎖を組み込んだグラフト高分子化 台物を台成し、この高分子と下層表面官能基とのカップ リング反応により形成することもできる。

明の区画培養基板の特徴の一つである。熱、酸または福 射線により朝疎水性が変化する官能量(極性変換量)に ついて説明する。極性変換基としては、線水性から親水 性に変化する官能基と、親木性から疎木性に変化する官 能量の2種類がある。

【0016】(疎水性から領水性に変化する官能量) 草 水性から親水性に変化する官能基としては、文献記載の 公知の實能基を挙げることができる。 これらの官能基の 有用な例は、特開平10-282672号公銀に記載の ミド、EP0652483、WO92/9934記載の アルコキシアルキルエステル、H. Itoち着 Macror nolecules, vol.21, pp.147記載のt-ブチルエステ ル、その他、シリルエステル、ピニルエステルなどの文 献記載の酸分解性基で保護されたカルボン酸エステルな

【0017】また、角岡正弘巻、「表面」vol.133(199) 5)、pp.374記載のイミノスルホネート墓、角岡正弘着、 Polymer preprints, Japan vol.46(1997), pp.2045記載 のβケトンスルホン酸エステル類、山岡亜夫者、特開昭 20 ルオキシ基;モーブチルオキシカルボニルオキシ甚など 63-257750号のニトロペンジルスルホネート化 合物も挙げることができるが、これらの官能基に限定さ れる訳ではない。これちのうち、特に優れているのは下 記に示される2級のアルキルスルホン酸エステル基、3 級のカルボン酸エステル基。および下記に示されるアル コキシアルキルエステル基である。

【()() 18】本発明において、疎水性から親水性に変化 する官能基として特に優れている2級のアルキルスルホ ン酸エステル無としては 下記一般式(1)で表される ものである。

[0019]

どを挙げることができる。

[ft1]

【0020】(一般式(1)式中、しはポリマー骨格に 連絡するのに必要な多価の非金属原子から成る有機基を 表し、R1、R1は置換もしくは非置換アルキル基を表 す。また、R¹、R¹はそれが結合している2級炭素原子 (CH) と共に環を形成してもよい。) 【0021】前記一般式(1)のR1、R1は耀換もしく

は非面換アルキル、置換もしくは非面換アリール基を表 し、また、R1、R1はそれが結合している2級炭素原子 (CH)と共に環を形成してもよい。R'. R'が配換も しくは非遺換アルキル基を表すとき、アルキル基として はメチル基、エチル基、イソプロピル基、モーブチル 基 シクロヘキシル基などの直線状 分娩状もしくは器 状のアルキル基が歩げられ、炭素数1から25までのも のが好適に用いられる。R1、R1が面換もしくは非置換 アリール基を表すとき、アリール基には炭素環式アリー 50 【0024】

ル華と復素機式アリール華が含まれる。炭素機式アリー ル基としてはフェニル基。ナフチル基。アントラセニル 基。ビレニル基など炭素数6から19のものが用いられ る。また、複素項式アリール基としてはピリジル幕、フ リル基、その他ペンゼン環が循環したキノリル基。ペン ゾフリル基、チオキサントン基、カルバゾール基などの 炭素数3~20 ヘテロ原子数1~5を含むものが用い 5h3-

【0022】R1、R1が面換アルキル華、置換アリール アルキルスルホン酸エステル、ジスルホン、スルホンイ 10 基であるとき 置縁基としてはメトキシ基。エトキシ基 などの炭素数1~10までのアルコキシ基、フッ素原 子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、トリフル オロメチル基、トリクロロメチル基のようなハロゲン産 換されたアルキル基、メトキシカルボニル基、エトキシ カルボニル基。モーブチルオキシカルボニル基。カーク ロロフェニルオキシカルボニルなどの炭素数2から15 までのアルコキシカルボニル基またはアリールオキシカ ルボニル基;水酸基;アセチルオキシ、ベンゾイルオキ p ージフェニルアミノベンゾイルオキシなどのアシ のカルボネート墓;モーブチルオキシカルボニルメチル オキシ基、2-ビラニルオキシ基などのエーテル墓:ア ミノ墓、ジメチルアミノ墓、ジフェニルアミノ墓。モル フォリノ基、アセチルアミノ基などの密機、非面換のア ミノ蟇;メチルチオ基、フェニルチオ華などのチオエー テル華;ピニル華、ステリル基などのアルケニル華;ニ トロ墓:シアノ墓:ホルミル基、アセチル基、ベンゾイ ル基などのアシル基;フェニル基、ナフチル基のような アリール基;ビリジル基のようなヘテロアリール基等を 30 挙げることができる。また、R1 R2が微換アリール基 であるとき、置換基としては、前述したものの他にもメ チル基、エチル帯などのアルキル基を用いることができ

ъ, 【0023】上記のR1、R1としては、保存安定性に優 れる点で、護換、非護袋のアルキル部が好ましく、経時 安定性の点で、アルコキシ華、カルボニル基、アルコキ シカルボニル基、シアノ基、ハロゲン基などの電子吸引 性基で薩換されたアルキル草、 もしくはシクロヘキシル 基、ノルボルニル基などのアルキル基が特に好ましい。 49 物性値としては、重クロロホルム中、プロトンNMRに おける2級メチン水素のケミカルシフトが4.4 ppm よりも低磁場に現れる化合物が好ましく、4.6ppm よりも低磁場に現れる化合物がより好ましい。このよう に、電子吸引性量で置換されたアルキル基が特に好まし いのは、熱分解反応時に中間体として生成していると思 われるカルボカチオンが電子吸引性華により不安定化 し、分解が抑制されるためであると考えられる。具体的 には、-CHR'R'の構造としては、下記式で表される 構造が特に好ましい。

特開2003-9860

基としてはメチル基、エチル基等の炭素数1から20ま でのアルキル菌、フェニル幕、ナフチル基等の炭素数6 から16までのアリール番 水酸基 カルボキシル基、 スルボンアミド華、N-スルホニルアミド基、アセトキ シ蟇のような炭素数1から6までのアシルオキシ蟇、メ トキン基、エトキシ基のような炭素数1から6までのア ルコキシ基、塩素、臭素のようなハロゲン原子、メトキ シカルボニル華、エトキシカルボニル華、シクロヘキシ ルオキシカルボニル基のような炭素数2から7までのア ルコキシカルボニル基、シアノ基、モーブチルカーボネ 50 【0036】式中R'は水素原子を衰し、R'は水素原子

【9027】多価の連結書が置換基を有する場合、置換 40 ートのような炭酸エステル基等を用いることができる。 【0028】本発明において、緑水性から親水性に変化 する官能基として特に優れているアルコキシアルキルエ ステル基としては、下記一般式 (2) で表されるもので ある. [0029] [fb4]

(6)

【0031】以上、本発明における疎水性から頼水性にま

*変化する官能量としては、一般式(1)で表される2級 のアルキルスルホン酸エステル基が特に好ましい。前記 一般式(1)~(2)で表される官能差(官能差(1) ~ (13)]の具体例を以下に示す。 [0032]

10

[fb5]

[0033]

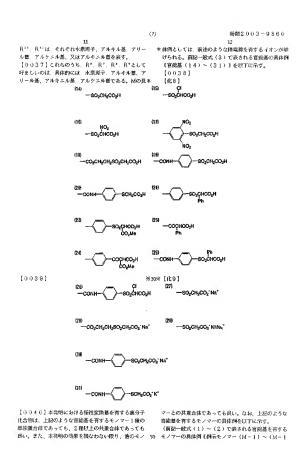
[化7]

(13)

[0034] (競水性から疎水性に変化する官能量) 本 発明において、熱、酸または輻射線により親水性から線 水性に変化する官能基としては、公知の官能基 例え ば 特開平10-296895号及び米国特許第6, 1 90、830号に記載のオニウム塩基を含むボリマー、 特にアンモニウム塩を含むボリマーを挙げることができ る。具体的なものとして、(メタ)アクリロルオキシア ルキルトリメチルアンモニウムなどを挙げることができ る。また、下記一般式(3)で示されるカルボン酸基お よびカルボン酸塩基が好適なものとして挙げられるが、 これらの例示に特に限定されるものではない。 [0035]

【0036】(式中、Xは-O-、-S-、-Se-、 -NR*-. -CO-. -SO-. -SO:-, -PO -. -S+R*R*-、-CS-を表し、R*、R* R®、R®は各々独立して1個の基を表し、Mは陽電前を 有するイオンを表す。) R*、R*、R*、R*の具体例としては - F、- C 1、

-Br, -1. -CN, -R**, -OR**, -OCOR 10. -OCOOR10, -OCONR10R11, -OSO, R10. -COR10, -COOR10, -CONR10R10, -NR**R**. -NR**-COR**. -NR**-COO R**. -NR**-CONR**R**, -SR**, -SOR 50 **. - SO, R**、- SO, R**等が挙げられる。R**、



[0045] [(b13] 600

【0046】「支持体表面】 玄発期の区面接着基続は 前述の極性変換器を有する高分子化合物の末端が直接ま 36 すことがより好ましい。 たは終高分子化合物を介して化学的に結合した表面グラ フト層と該高分子化合物の末端が直接または幹高分子化 合物を介して化学的に結合できるような支持体表面を有 するものである。先に述べたように、支持体の表面自体 がこのような特性を有していてもよく、このような特性 を省する中間層を支持体表面に設けてもよい。 【0047】(支持体表面或いは中間層) このような支

特体表面は、前記表面グラフト層をグラフト台成して設 けるのに適した特性を有していれば、無機層、有機層の 化合物からなる画像形成層により視疎水性の変化を発現 するため表面の頻性は問題ではなく、親水性であっても また疎水性であってもよい。このような中間層において は、特に、光グラフト重合法、プラズマ昭射グラフト重 台法 放射線照射グラフト重台法により本発明の蔵層ボ リマーを合成する場合には、有機表面を有する層である ことが好ましく 特に有機ポリマーの層であることが好 ましい。また有機ポリマーとしてはエポキシ鎖艦 アク リル樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、スチレン系

勧請: メラミン系樹脂、フォルマリン樹脂などの合成樹 脂、ゼラチン、カゼイン、セルロース、デンプンなどの 天然樹脂のいずれも使用することができるが、光グラフ ト重合法、プラズマ照射グラフト重合法、放射線解射グラフト重合法、放射線解射グラフト ラフト重合法などではグラフト重合の開始が有機ポリマ 一の水素の引き抜きから進行するため、水素が引き抜か れやすいポリマー、特にアクリル報題、ウレタン樹脂、 スチレン系制脂、ビニル系樹脂、ポリエステル樹脂、ポ リアミド系翻贈、エポキン樹脂などを使用することが、 10 特に製造遺性の点で好ましい。このような中間層は、後 述の基板(支持体)を兼ねていても良く、また必要に応 じて支持体上に設けられた中間圏であってもかまわな

【0048】また、本発明の画像形成材料においては、 極性変換基を資するグラフト層の形成性、支持体との窓 着性の観点から、前記高分子化合物が直接化学結合して いる支持体として、形成されるパターンの解像度への影 響を及ぼさない範囲においてその表面が粗面化されてい るものを用いることもできる。種面化した支持体を用い 20 る場合には、その表面性状は以下の条件を満たすもので あることが好ましい。粗面化された支持体の好ましい状 懸としては、2次元租さバラメータの中心線平均組さ (Ra)が0.1~1µm,最大高さ(Ry)が1~1 0 μm, 十点平均租さ (Rz) が1~10 μm, 凹凸の 平均間隔 (Sm) が5~80 μm、局部山頂の平均間隔 (S)が5~80µm、最大高さ(Rt)が1~10µ m. 中心線山高さ (Rp) が1~10 μm、中心線谷深 さ(Rv)が1~10 µmの範囲が挙げられ、これらの ひとつ以上の条件を満たすものが好ましく、全てを満た

【0049】(光熱変験物質)なお、本発明の区面結構 基板にIRレーザーなどでバターン形成を行う場合に は、該光エネルギーを熱エネルギーに変換するための光 熱変換物質を区面培養基板のどこかに含有させておくこ とが好ましい。光熱変換物質を含有させておく部分とし ては、例えば、親/線水性が変化するグラフト層、中間 圏. 支持体基板のいずれでもよく、さらには、中間層と 支持体基板との間に光熱変換剤腫を設け、そこに添加し てもよい。

いずれでおよい。また本発明においては、薄層の高分子 40 【0050】本発明の区圏培養基板に用い得る光熱変換 物質としては、熱外線、可視光線、赤外線、白色光線等 の光を吸収して熱に変換し得る物質ならば全て使用でき るが、培養する細胞、細菌類、DNAなどへの影響を希 慮して選択することが好ましい。用い得る光熱変換剤と しては、例えば、カーボンブラック、カーボングラファ イト、顔料、フタロシアニン系顔料、鉄粉、鳥鉛粉末、 酸化鉄粉、酸化鉛、酸化銀、酸化クロム 硫化鉄 硫化 クロム等が挙げられる。本発明において特に好ましいの は、書き込みに使用する赤外線レーザの電光波長である 樹脂。ビニル系樹脂、ボリエステル樹脂、ボリアミド系 50 760 nmから1200 nmに極大吸収波長を育する染

(11)

料、飼料または金属機粒子である。

【0051】染料としては、市販の染料及び文献(例え ば、「染料便服」有機合成化学協会編集、昭和45年 刊) に記載されている公知のものが利用できる。具体的 には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ビラゾロンアゾ染 料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボ ニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン 染料、金属チオレート錯体等の染料が挙げられる。 好き しい染料としては、例えば、特闘昭58-125246 号、特開昭59-84356号、特開昭59-2028 10 有層全國形分の0.01~50重量%、好ましくは0. 29号、特開昭60-78787号等に記載されている シアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭5 8-181690号、特開昭58-194595号等に 記載されているメチン染料、特開昭58-112793 号、特闘昭58-224793号、特開昭59-481 87号、特別昭59-73996号、特別昭60-52 940号、特開昭60-63744号等に記載されてい るナフトキノン染料、特開昭58-112792号等に 記載されているスクワリリウム色素、英国特許434、 875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。 【0052】また、米国特許第5、156、938号記 戴の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国等 **許算3.881.924号記載の関係アリールベンゾ** (チオ) ビリリウム塩、特開昭57-142645号 (米国特許第4.327、169号) 記載のトリメチン チアビリリウム塩、特開昭58-181051号、同5 8-220143号、同59-41363号、同59-84248号、同59-84249号、同59-146 063号、同59-146061号に記載されているビ リリウム系化合物、特別昭59-216146号記載の 30 シアニン色素、米国特許第4、283、475号に記載 のベンタメチンチオビリリウム塩等や特公平5-135 14号、同5-19702号公報に開示されているビリ リウム化合物も好ましく用いられる。また、好ましい別 の染料の例として、米国特許等4、756、993号明 細書中に式(I)、(II)として記載されている近赤外 吸収染料を挙げることができる。これらの染料のうち特 に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウ ム色素、ビリリウム塩、ニッケルチオレート縄体が挙げ 5h3.

【0053】本発明において使用される顔料としては、 市販の顔料及びカラーインデックス (C. I.) 便覧、 「最新顔料便覧」(日本顔斜技衛協会編、1977年 刊》: 「最新頒糾応用技術」 (CMC出版、1986年 刊) 「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊) に記載されている顔料が利用できる。顔料の種類として は 単色顔料 黄色顔料 オレンジ色顔料 褐色顔料 赤色條料、紫色條料、青色條料、綠色條料、紫光條料。 金属紛顛料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。

ゾ顔斜、キレートアゾ顔斜、フタロシアニン系顔斜、ア ントラキノン系顔料、ペリレン及びベリノン系顔料、チ オインジゴ系機科、キナクリドン系顔料、ジオキサジン 系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔 料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニ トロ顔料、天惣顔料、黄光顔料、泉機顔料、カーボンブ ラック等が使用できる。これらの顔料のうち好ましいも のはカーボンブラックである。

【0054】これらの染料又は顔料は、光熱変換物質含 1~10重置%. 染料の場合符に好ましくは0.5~1 ①重量%、顔斜の場合特に好ましくは3、1~10重置 %の割合で使用することができる。顔斜又は染料の添加 置がり、01重量%未満であると思度が低くなり、また 50 重畳%を械えると光熱変換物質含濃層の臓器度が明 くなる。

【0055】(支持体基板) 水発明の区面線養益板に使 用され、その表面に前記特性を備えたグラフト層を有す る支持体(基板)は寸度的に安定な板状物であることが 20 好ましく、例えば、紙、プラスチック(例えば、ポリエ チレン、ボリプロピレン、ポリスチレン等) がラミネー トされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜鉛、銅 等)、プラスチックフィルム (例えば、二酢酸セルロー ス. 三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸 セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ボ リエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレ ン、ポリプロビレン、ボリカーボネート、ボリビニルア セタール等). 上記の如き金属がラミネート若しくは蒸 着された紙着しくはプラスチックフィルム等が含まれ る。本発明に使用される支持体としては、ポリエステル フィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中でも、

前記下層を競ねることができるポリエステルフィルムが 特に好ましい。基材として使用するアルミニウム板には 必要に応じて前途のような組面化処理。陽極酸化処理な どの公知の表面処理を行なってもよい。 【0056】また、他の好ましい厳様であるボリエステ ルフィルム等のプラスチックフィルムを用いる場合に

6. 額/線水性グラフト層の形成性 密着性の額点か ち、前述の粗面化処理を施されたものを用いることも可 40 能である。

【0057】なお、本発明の区面培養基板に使用される 支持体が、前記中間層を兼ねる場合は、前記中間層にお いて詳述した樹脂材料からなるフィルムそのものを用い るととができ、との場合には、前記のように親ノ疎水性 グラフト層を構成する高分子化合物が直接化学結合して いる支持体表面が粗面化されているものを用いることも できる。

【0058】 〔バターン形成方法〕つぎに、このように して得られた本祭明に係る区面培養基板のパターン影成 具体的には、不溶性アゾ朔斜、アゾレーキ顔料、縮合ア 50 方法について説明する。本発明の区面培養基板のバター

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N...

21

ン形成級機では、前記グラフト層中の高分子化合物の極 性変換基が加熱、または輻射線照射循域において極性変 換し、親水性咳いは疎水性の鎖域が形成される。このと き、飼料、露光領域が親水性を発現する領域となる場 合。そこが細胞非接着性領域となり 非加熱領域 また は未露光領域においては、疎水性層がそのままの表面状 療で残存するととになり、細胞接着性鋼域となる。ま た、 削熱、露光部が篠水性難域となる場合には そこが 細胞接着性領域となり、また、非加熱領域、または未露 光師域においては、親水性層がそのままの表面状態で残 19 腕を接着させて用いることもできる。 存することになり、細胞非接着領域となる。ここで、細 **慶季接着性領域における親水性の程度としては、電荷を** 有さず接触角が5()度以下の親水性表面であることが好 ましいが、本発明における表面親水循域はいずれも拡張 濡れを示す程度の高い親水性を有するものである。 【0059】(書き込み)本発明の画像形成材料への画 俊の書き込みは、光などの輻射線の昭射或いは匍執によ り行われる。また、光照射の一麼様として、前記光熱変 換材料を併用するタイプであれば、赤外線領域のレーザ 一光等の走査器光による飼熱により、画像形成すること 20 子化合物などがあげられるが、これらに限定されるもの も可能である。画像形成に用いる方法としては、無熱、 霧光等の輻射線照射により書き込みを行う方法が挙げら れる。例えば、赤外線レーザ、紫外線ランプ、可視光線 などによる光照射、ヶ線などの電子線昭樹、サーマルへ ッドによる熱的な記録などが可能である。これらの光源 としては、例えば、水銀灯、メタルハライドランプ、キ セノンランプ、ケミカルランプ、カーボンアーク灯等が ある。放射線としては、電子線、X線、イオンビーム、 遠赤外線などがある。またg線、1線、Deep-UV される。一般的に用いられる異体的な態機としては、約 記録ヘッド等による直接画像機記録、赤外線レーザによ る走査選先、キセノン放電灯などの高眼度フラッシュ基 光や赤外線ランプ露光などが好適に挙げられる。コンピ ュータのデジタルデータによるダイレクト画像形成を行 うためには、レーザ鑑光により福性変換を生起させる方 法が好ましい。レーザとしては、炭酸ガスレーザ、窒素 レーザ、Arレーザ、He/Neレーザ、He/Caレ ーザ。Kェレーザ等の気体レーザ、液体(色素)レー ザ、ルビーレーザ、Nd/YAGレーザ等の関体レー ザ. GaAs/GaAIAs、InGaAsレーザ等の 半導体レーザ、KFFレーザ、XeC1レーザ、XeF レーザ、Arz等のエキシマレーザ等を使用することが できる。なかでも、波長700~1200 n mの赤外線 を放射する半導体レーザ、YAGレーザ等の固体高出力 赤外線レーザによる露光が好適である。

【9060】(表面グラフト重合の極性) 先に具体的に 例示した一般式(1)で表されるアルキルスルホン酸エ ステル基などの如きアニオングラフト振性変換官能基を 有するグラフト層では、無熱、露光領域のみが蘇水性か 50 利点を有する。なかでも、DNAにはリン酸基が存在す

ら額水性に変化し、細胞非維着領域を形成する。このよ うなパターン形成級機を用いる場合には、非加熱、未露 光部は極性変換されず、基材のままの疎水性を維持し、 細胞接着鎖域となる。効果の観点からは、非加熱、未露 光部鋼域に細胞接着性の高いカルボキシル基やアミノ基 などの官能基を育することが好ましい。この細胞接着性 領域は、目的に応じて、そのまま細胞を接着させる方法 で用いてもよく、また、細胞接着性を有するペプチト類 などの高分子化合物を導入して、その後、目的とする細

22

【0061】解記線D接着性を有する高分子化合物の重 体例としては、例えば、ポリアクリル酸、ポリビニル硫 酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリアリルアミンなどの 電荷を有する高分子化合物。 コンドロイチン硫酸、デル マタン硫酸、デキストラン硫酸、ケラタン硫酸、ヘパラ ン硫酸、ヒアルロン酸、キチンなどの電荷を有する多様 類 コラーゲン、ゼラチン、フィブロネクチン、ハイド ロネクチンなどの細胞接着性タンパク質、さらには細胞 接着性タンパク質や細胞接着性ペプチドを固定した高分 ではない。

【0062】他のパターン形成機構として、例えば、特 関平10-296895号公銀に記載のアンモニウム基 などの如きカチオングラフト福性変換官能基を育するグ ラフト層では、もともとの表面が正の電荷を有してお り、離光或いは傾熱領域のみが電荷を消失するようにな る。従って、とこが細胞吸着性の領域となる。

【0063】以上の方法で、パターン形成された本登明 の区面培養基板は、常法により細胞を培養することによ 光. 高密度エネルギービーム (レーザービーム) も使用 30 り. 細胞配列を容易に制御でき、露光条件によってはサ ブミクロン (0.3~0.5 μ m程度の) オーダーまで の高解像度の微細パターンを形成することができる。こ のため、形成された微細パターンは、タンパク質や細胞 の解析、医薬品の効果の額認などの用途のみならず、バ イオセンサー、スイッチング電子、バイオリアケター DNAチップ、人工職器などの製造、さらにはニューロ コンピューターなどの開発にも有用である。

【0064】本発明の区面培養基板は、DNAチップに 有用である。DNAチップは基材表面に数umから数十 40 μmのオーダーの微細なパターンを形成し、そこに比較 的短い合成DNAを共有結合させて形成するもので、バ ターンの区画毎に複数種の予め知られた配列を育する異 なるDNAを導入して形成されるものであり、このDN Aの吸着領域を前記パターン形成方法により形成するも のである。DNAの吸着には、先に述べた供給結合によ るものとイオン結合によるものがあるが、本発明の如き 観疎水性が変化するグラフトボリマーを使用する場合に は、DNAとグラフトポリマーの種類とを選択すること により、いずれの方法にも適用することができるという

締脚2003-9866

るため負電荷を有しており、親水的なカチオングラフト

と相互作用しやすいと考えられ、吸着強度の観点から も、イオン結合による吸着が有用である。本発明により 得られたDNAチップは、解像度に優れた機器なパター ンを容易に形成することが可能であるため、遺伝子診断 やDNAの余知の類基配列の決定などの用途への展開が 期待される。

23

[0065]

【実総例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明す*

(中間磨塗布液)

・エポキシ樹脂(エピコート, Yuka-shell Go,Ltd.) ·赤外線吸収剤(|R125 和光純薬剤) 1ーメトキシー2ープロバノール ・メチルエチルケトン

【0067】中間層を形成した支持体表面を次の条件に てプラズマ処理して表面グラフト重合による画像記録屋 の形成を行った。島津製作所製LCVD-01型プラズ マ処理装置を用いて(). () 4 toprのアルゴンガス雰囲気 下にて10秒間処理後、空気に襲し、中間層表面にパー レン-4-スルホニル) 酢酸ナトリウム塩水溶液に浸漬 し、15分間アルゴンガスをバブルしたのち、7時間6 ○*Cに加温することによってグラフト重合を行った。グ ラフト重合後膜を3000mlのイオン交換水中につ け、グラフト重合以外のホモポリマーを除去することに よりプラズマ処理により表面にグラフトされた表面を備 えた区回培養基板原板Aを得た。

【0068】 (バターン形成) 得られた区面培養基板原 板Aを波長830nmの赤外光を発する赤外線レーザ (ビーム径20 um) にて幅20 umの線状の数光を1 30 0 μηの空白を隔てて基板の緑端に像繊維光し、格子様 様のמ光パターンを形成した区画培養基板Aを得た。露 光後、培養細胞として牛血管内皮細胞を用い、培養方法 としては、汎用の方法を用いて細胞培養を行った。区画 培養基板の表面に血管内皮細胞を1×101cells/alに 調整した細胞疑濁液を塗布し、37°CのCO、インキュ ベーター内で24時間絶費を行ったところ、格子模様の 内側の正方形のパターンの細胞接着領域(未露光部鎖 域)のみに内皮細胞が伸展・増殖しており、所望の細胞 の配列パターンが得られた。

[0069] (実施例2)

(バターン形成材料の作製) 188 umのコロナ処理さ れた2軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム (A 4.100、東洋紡(株) 額) を用い、グロー処理として 平版マグネトロンスパッタリング装置(CFS-10-EP70、芝浦エレテック製)を使用し、下記条件で酸 素グロー処理を行った。

[0070]

初期真空: 9×10°toor 酸素圧力: 6.8×10'toor * るが、本発明はこれらに限定されるものではない。 [実施例1]

0.2 g

(区面培養基板原版の作録) 188μmのコロナ処理さ れたポリエチレンテレフタレートフィルムを支持体とし て用い、その表面に下記の組成をロッド10番の途高バ ーを使用して盆布し、100℃で1分乾燥し、赎厚1. 6 μ mの赤外線吸収剤を含有する中間層を作成した。 [0066]

24

RFグロー: 1. 5 kw 処理時間:60 sec

【0071】次に、グロー処理したフィルム上に、下記 例示モノマー (M-3) のメチルエチルケトン溶液 (5) 0 w t %) を塗布し、100℃で1分乾燥し、UV光で オキシド基を導入した。この膜を10w1%のα(スチ 20 照射(400▽高圧水銀灯 30分)してグラフト重台 を行い、グラフト圏を形成した。さらに、下記構造の光 熱変換色素 (IR-A) の5重量%アセトニトリル密液 をロッドバー#?で途高し グラフト層に光熱変換色素 を含省させて区画培養基板原板Bを得た。

> [0072] [ft14] M - 1

【0073】(國像影成:バターン形成) 得られた区画 培養基板原板Bを波長830nmの赤外光を発する赤外 線レーザ(ビーム径20μm)にて実総例1と同様に像 機に繋光し、バターン形成された区面培養基折れる様 た。露光後、区面培養基板Bを用いて実施例1と同様の 細胞培養を行ったところ、細胞接着循域(未載光部鎖 50 域)のみに内皮細胞が伸展・増殖しており、露光領域の (14)

特開2003-9860

がわかった。

【発明の効果】本発明の区画培養基板は、露光敷いは加 熱により高層度、高解度度で、細胞の乳酸着領域に好適* 形成が可能なDNAチップを得ることができる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 48024 AA11 AA20 CA01 CA11 M11 48029 AA01 AA21 AA23 8811 8820 CC02 48055 AA90X BC41 8C50 CA44 CA46